課題番号 :F-18-TU-0055

利用形態:機器利用

利用課題名(日本語) : HALSAW デバイスの開発

Program Title (English) : Research of hetero acoustic layer (HAL) elastic devices

利用者名(日本語):門田道雄,柚木良美

Username (English) : M. Kadota, Y. Yunoki

所属名(日本語) :東北大学大学院工学研究科

Affiliation (English) : Graduate School of Engineering, Tohoku University

キーワード/Keyword :成膜・膜堆積, HALSAW 共振子, SAW 共振子

### 1. 概要(Summary)

スマートフォンの普及により、移動体通信帯の周波数に は80を超えるバンドがあり、非常に過密している。そのた め、急峻な肩特性をもち、かつ温度変動に対し周波数の 変化しない良好な周波数温度特性(TCF)が要求される。 また、近年のキャリアアグリゲーション方式の採用により、 高周波までスプリアスのないフィルタ特性が要求される。 そのフィルタは共振子をはしご型に接続したラダーフィル タで構成されており、上記の 3 つの要求を満たすために は、高インピーダンス比(共振と反共振子インピーダンス の比)、良好な TCF、高周波までスプリアスのない共振子 が要求される。移動体通信用デバイスでは LiTaO3(以 下LT)やLiNbO3(以下LN)が用いられているが、これら は温度に対し周波数が低下するマイナスのTCFを持ち、 最も良好なTCFを示す42°YX-LTでも-49 ppm/°Cであ る。筆者らは、唯一水晶基板が方位角により、マイナス、 ゼロ、プラスの3種のTCFを持つことに着目し、プラスの TCF をもつ方位角の水晶基板とマイナスの TCF を持つ LT薄板とを組み合わせたHALSAWデバイスで、従来の 1/25 の+2 ppm/°C と良好な TCF、従来より 31 dB 高い 82 dB の高インピーダンス比に加え、14 GHz までスプリ アスのない特性を実現した。

#### 2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】 芝浦スパッタ装置

【実験方法】Cu 電極/LT薄板/水晶基板構造 HALSAW 共振子の試作を行った。参考として示す従来の 42YXLTSAW基板からなるSAW共振子も作成した。LTと 水晶を接合後、LT 基板を0.44~1 μmまで研磨し、その後、 EB 露光装置、Cu 蒸着等を経て、HALSAW 共振子を作 製した。

## 3. 結果と考察 (Results and Discussion)

作製した従来 SAW 共振子と HALSAW 共振子では、 従来 SAW 共振子に比べ 31 dB 高い 82 dB のインピーダ ンス比を実現した[1]。一方、図1に示すように LT 厚 0.16 波長における HAL SAW 共振子の温度変動は従来 SAW

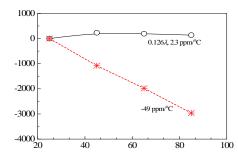


Fig. 1 Measured temperature dependence of resonant frequency for standard SAW (broken line) and HAL SAW (solid line) resonators with LT thicknesses of  $0.126\lambda$ 

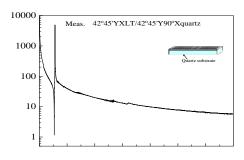


Fig. 2 Measured frequency characteristic of HAL SAW resonator.

共振子に比べ 1/25 と小さく、その TCF は+2 ppm/ $^{\circ}$ C である $^{[1]}$ 。図 2 は HALSAW の周波数特性を示し、14 GHz まで、まったくスプリアスがない $^{[2]}$ 。このように LT 薄板と水晶基板を組み合わせた HALSAW で、移動体通信における 3 つの要求をすべて満足する特性を実現した。

## 4. その他・特記事項(Others)

本研究の一部は、総務省の戦略的情報通信研究開発 推進事業(SCOPE)(175002002)の委託を受けた。

# 5. 論文·学会発表 (Publication/Presentation)

[1] M. Kadota and S. Tanaka, Proc. IEEE Freq. Cont. Symp., THO1,3-2, 2019.

[2] M. Kadota and S. Tanaka, Proc. IEEE Ultrason. Symp, 6J-2, 2018.

#### 6. 関連特許(Patent)

US 仮出願1件